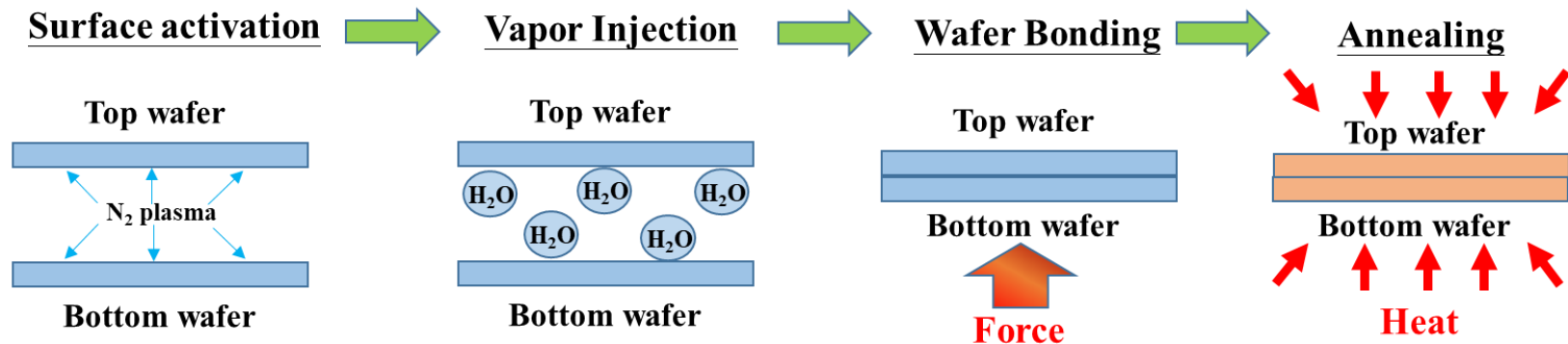


Bonder標準製程



- **Wafer Bonding**：提供標準的氧化層對氧化層，晶圓對晶圓的鍵合製程。晶圓表面會經由氮氣電漿活化，再導入水蒸氣為後續氫鍵鍵合做準備，最後施一壓力將兩片晶圓鍵合。
- **Post Annealing**：在晶圓鍵合後，昇溫至 $300^{\circ}C$ 維持2小時做退火，將水氣進一步排出，以提升晶圓鍵合強度。升溫速率為 $1^{\circ}C/min$ 。